

końca nierozciąganego odcinka pasa klinowego (29), na wspólnej osi łączącej oś trzpienia (63) z osią wału odbiorczego (71). Wał (71) łożyskowany jest w korpusie przekładni i połączony z wałem napędzanym (59) przez przekładnię zębatą (61, 72).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 427594 (22) 2018 10 30

(51) B64C 39/02 (2006.01)

- (71) AEROKLUB ZIEMI LUBUSKIEJ STOWARZYSZENIE,
Zielona Góra
(72) MRÓWCZYŃSKA MARIA; GIBOWSKI SŁAWOMIR;
GRZELAK BARTŁOMIEJ; KAZAK JAN; WILER JĘDRZEJ

(54) Sposób pozyskiwania i opracowania danych fotogrametrycznych zwłaszcza niskiego pułapu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób pozyskiwania i opracowania danych fotogrametrycznych zwłaszcza niskiego pułapu, charakteryzujący się tym że obejmuje następujące etapy: a) wyznacza się podstawowe parametry nalotu, takie jak pokrycie poprzeczne i podłużne, wysokość lotu oraz opracowuje się plan nalotu, b) przeprowadza się nalot z udziałem platformy badawczej składającej się z bezzałogowca, kamery oraz urządzenia przetwarzającego dane i informacje, c) prowadzi się kontrolę dokładności i rozdzielczości pozyskanego materiału, d) opracowuje się mapę numeryczną opisującą realizację sytuacyjną 2D lub przestrzenną 3D.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 427530 (22) 2018 10 23

(51) B65D 5/64 (2006.01)

- (71) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie
(72) ANTKOWIAK ARTUR
(54) Kłapa zamykająca opakowanie z taśmą klejącą i sposób wykonania klapy

(57) Kłapa zamykająca opakowanie z taśmą klejącą na nośniku charakteryzuje się tym, że taśma klejąca (3) rozciąga się przynajmniej od jednej, swobodnej krawędzi klapy zamykającej opakowanie (4), a w tej krawędzi (5) klapy (4), po obu stronach taśmy klejącej (3), znajdują się wycięcia (6), przy czym odległość między sąsiadującymi krawędziami wycięć (6) przy krawędzi (5) klapy zamykającej opakowanie (4) jest równa lub większa od szerokości warstwy klejącej taśmy klejącej (3), a szerokość nośnika jest większa od odległości między sąsiadującymi krawędziami wycięć (6) przy krawędzi (5) klapy

A1 (21) 431561 (22) 2019 10 22

(51) C01B 21/06 (2006.01)
C04B 35/58 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)

- (71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) JANIK JERZY FRANCISZEK; DRYGAŚ MARIUSZ;
KAPUSTA KATARZYNA; BUČKO MIROSLAW;
OLEJNICZAK ZBIGNIEW; PAŁOSZ BOGDAN;
STELMACH SWITLANA; GIERLOTKA STANISŁAW
(54) Sposób wytwarzania nanoceramiki azotkowej typu GaN/AlN, GaN/AlGaN/AlN i AlGaN

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania, nanoceramiki azotkowej typu GaN/AlN, GaN/AlGaN/AlN i AlGaN, który polega na tym, że do świeżo wytworzonego dimetyloamidku litu $\text{LiN}(\text{CH}_3)_2$ dodaje się w proporcji stechiometrycznej chlorek galu GaCl_3 w rozpuszczalniku, korzystnie roztworze heksanu lub heksanu i eteru dietylowego oraz oddzielnie do świeżo wytworzonego dimetyloamidku litu $\text{LiN}(\text{CH}_3)_2$ dodaje się w proporcji stechiometrycznej chlorek glinu AlCl_3 w rozpuszczalniku, korzystnie roztworze heksanu lub heksanu i eteru dietylowego. Po usunięciu produktów ubocznych w postaci LiCl i odparowaniu rozpuszczalników, każdy z produktów reakcji oczyszcza się przez sublimację w temperaturze 110°C , przy ciśnieniu 10 Pa i otrzymuje tris(dimetyloamidek) galu $[\text{GaN}(\text{CH}_3)_2]_3$ oraz tris(dimetyloamidek) glinu $[\text{AlN}(\text{CH}_3)_2]_3$, które miesza się ze sobą w heksanie przez czas od 1 minuty do 10 godzin w proporcji molowej 1:1 i po odparowaniu heksanu poddaje reakcji z ciekłym amoniakiem w temperaturze -33°C przez 4 godziny, a następnie wygrzewa w atmosferze przepływającego gazowego amoniaku, w temperaturze $800 - 1000^\circ\text{C}$, przez okres od 1 do 20 godzin. Uzyskany nanoprosek o średnim rozmiarze krystalitów $10 - 20\text{ nm}$, będący mieszaniną azotku galu w formie heksagonalnej h-GaN, azotku glinu w formie heksagonalnej h-AlN oraz ewentualnie azotku glinowo-galowego o wzorze $\text{Al}_x\text{Ga}_{(1-x)}\text{N}$, gdzie $0,01 < x < 0,99$, umieszcza się w formie i spieka w temperaturze $600 - 1000^\circ\text{C}$, pod ciśnieniem $3 - 10\text{ GPa}$, przez okres od 1 minuty do 10 godzin, uzyskując kształtki będące mieszaniną GaN i AlN lub mieszaniną GaN i $\text{Al}_x\text{Ga}_{(1-x)}\text{N}$, gdzie $0,01 < x < 0,99$ i AlN lub mieszanym azotkiem $\text{Al}_x\text{Ga}_{(1-x)}\text{N}$, gdzie $0,01 < x < 0,99$.

(1 zastrzeżenie)